課題番号	:F-14-NM-0049
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:電子ビーム描画装置等を用いたグラフェン/超伝導体接合を持つデバイスの作製
Program Title (English)	: Fabrication of Graphene/Superconductor device using EB lithography system
利用者名(日本語)	:古川 直紀
Username (English)	: <u>N. Furukawa</u>
所属名(日本語)	:東京理科大学大学院 理学研究科 応用物理学専攻
Affiliation (English)	: Graduate school of Science, Tokyo University of Science

<u>1. 概要(Summary)</u>

電子ビーム描画装置、多目的ドライエッチング装置、超 高真空電子銃型蒸着装置等を用いてグラフェンのエッチ ング、超伝導電極のパターニング及び蒸着を行い、レー ザー露光装置、12 連電子銃型蒸着装置を用いてボンデ ィングパッドの作製を行った。これにより、グラフェン/超 伝導体接合を持つデバイスの作製に成功し、その輸送特 性やそれに対する光照射効果の測定を行った。

<u>2. 実験(Experimental)</u>

【利用した主な装置】

100 kV 電子ビーム描画装置、多目的ドライエッチング 装置、レーザー露光装置、超高真空電子銃型蒸着装置、 12 連電子銃型蒸着装置、原子層堆積装置、室温プロー バーシステム、自動スクライバー、ワイヤーボンダー

【実験方法】

- 酸化膜(90 nm or 290 nm)付き Si 基板にレジスト (ZEP520A)を塗布し、EB 描画装置を用いて Dose 量 0.15 µsec/dot で描画を実行した。描画後、 Xylene、IPA の順で現像処理した。続いて多目的ド ライエッチング装置によりグラフェンをエッチングした 後、レジスト剥離を行った。
- ② 超伝導電極作製のため、上記同様に描画及び現像
 処理を行った後、超高真空電子銃型蒸着装置により
 Ti/Al/Ti = 10/100/5 nm を蒸着し、リフトオフした。
- ③ パッド作製のため、基板に下層レジスト(PMGI SF9)、上層レジスト(AZ5214)を塗布し、レーザー露 光装置を用いて Dose 量 140 mJ/cm² で描画を実行 した。描画後、TMAH2.38%、純水の順で現像処理 した。その後、12 連電子銃型蒸着装置を用いて Ti/Au = 10/100 nm を蒸着し、リフトオフした。
- ④ 試料基板全体に原子層堆積装置により絶縁膜を施 した後、試料部分直上にTi/Au = 10/100 nm を蒸

着してマスクとした。ここで、一部の試料のみ接合に 用いられたグラフェン直上部分に 4.2 μm×0.5 μm の スリットを設けた。尚、パッド直上の絶縁膜のみリフト オフしてコンタクトを取っている。

<u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

希釈冷凍機内部に光学系ごと試料を格納し、極低温下 における輸送特性を測定した。Fig.1 は超伝導体/グラフ エン/超伝導体接合(SGS 接合)における臨界電流値 (I_c)及び常伝導抵抗値(R_h)のバックゲート電圧(V_g)依存 性の測定結果である。 V_g による R_h 変調を介して I_c が制 御可能である。ここで、試料に対する波長 1.31 µm の光 照射を行い、 I_c 及び R_h の光パワー(P)変化を Fig.2 に示 す。その I_c の大きさは Pの増加に伴い、 R_h にはほとんど 変化が見られないにも拘らず単調減少していく。同等の I_c における Pと温度との対応関係から、この要因は光照射に よる G 中の電子温度の上昇により説明できるが、温度変 化と P変化における I_c 減少率の違い等、熱的効果のみで は説明できない現象も見られた。



Fig.1 (left) *L* and *R*_N as a function of Backgate voltage (*V_g*). Fig.2 (right) Normalized *L* and *R_N* as a function of light intensity(*P*). <u>4. その他・特記事項 (Others)</u> なし

<u>5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)</u>

古川ら,応用物理学会第 75 回秋期大会,平成 26 年 9 月 18 日

6. 関連特許(Patent)